

製品情報(法人向け/産業用)



PCIe M.2 SSDs

MTE662T2

PCI Express (PCIe) Gen 3 x4インターフェースを備えたトランセンドのMTE662T2 M.2 SSDは、NVM Express (NVMe) 1.3規格に準拠しており、これまでにないデータ転送速度を実現しています。ストレージ効率に優れた96層の3D NANDフラッシュ、高速アクセスを可能にするDRAMキャッシュ、信号伝送品質を高める30μインチ厚の金端子、主要部品の半田接合を補助するコーナーボンドを適用し、厳格な試験を実施することで3K P/Eサイクルや-20°C~75°Cでの動作を保証しています。

ハードウェアの機能

- 耐久性: 3K P/Eサイクル
- 30μインチ厚のPCB金端子部
- 主要部品にはコーナーボンド技術を適用しています
- DDR4 DRAMキャッシュ搭載
- 幅広い温度帯(-20°C~75°C)で動作可能

製品情報

512GB	TS512GMTE662T2
1TB	TS1TMTE662T2
2TB	TS2TMTE662T2

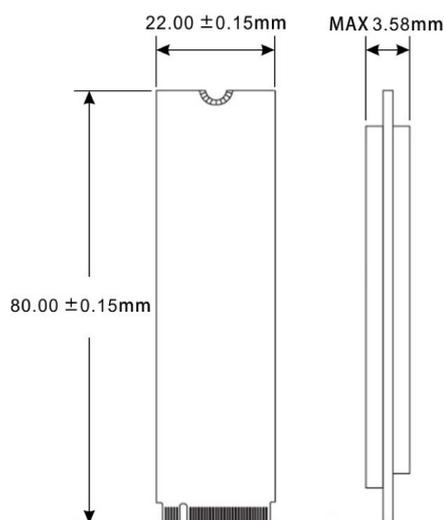
ファームウェアの機能

- SLCキャッシュ
- NVMeコマンド対応
- LDPC ECC機能
- ダイナミック・サーマル・スロットリング
- S.M.A.R.T.機能

仕様

外観	サイズ	80 mm x 22 mm x 3.58 mm (3.15" x 0.87" x 0.14")
	重量	9 g (0.32 oz)
	フォームファクタ	M.2
	M.2規格	2280-D2-M (両面実装)
インターフェース	バスインターフェース	NVMe PCIe Gen3 x4
ストレージ	フラッシュ種類	3D NANDフラッシュ
	容量	512 GB / 1 TB / 2 TB
動作環境	動作電圧	3.3V±5%
	動作環境温度	温度拡張 -20°C (-4°F) ~ 75°C (167°F)
	保管温度	-55°C (-67°F) ~ 85°C (185°F)
	湿度	5% ~ 95%
	耐衝撃	1500 G、0.5 ms、3軸
	耐振動(動作時)	20 G (最大振幅), 7 Hz ~ 2000 Hz (周波数)
電源	消費電力(動作時)	7.0 ワット
	消費電力 (IDLE)	1.0 ワット
データ転送スピード	シーケンシャルリード/ライト(CrystalDiskMark, 最大値)	読出し: 最大 3,500 MB/s 書込み: 最大 2,700 MB/s
	4Kランダムリード/ライト(IOMeter, 最大値)	読出し: 最大 340,000 IOPS 書込み: 最大 355,000 IOPS
	MTBF [平均故障間隔]	3,000,000 時間
	TBW [総書込み容量] (最大値)	4,400 TBW
	DWPD [1日あたりのドライブ書込み数]	2 (3年)
保証	認証	CE / FCC / BSMI
	保証	3年保証

寸法



製品仕様は予告なしに変更することがあります。そのため、掲載写真が実際の製品と異なる場合がございます。また、使用可能な製品容量は使用環境によって異なります。メモリ製品を使用するインダストリアルアプリケーションは多岐に渡り、使用条件や環境も様々であるため、トランセンドは全ての機器との互換性やあらゆる条件での安定動作を保証することができません。特定のアプリケーションや環境での使用を検討する際は事前にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。